

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Методики и условия проведения испытаний микроэлектронных изделий на радиационную стойкость	3
Рациональный методический подход к оценке дозовой стойкости КМОП-микросхем с учетом эффектов низкой интенсивности <i>Д. В. Бойченко, О. А. Калашников, А. Б. Каракозов, А. Ю. Никифоров</i>	4
Выбор оптимальных параметров лазерного излучения для моделирования объемных ионизационных эффектов в тонкопленочных кремниевых микросхемах <i>П. К. Скоробогатов, А. Ю. Никифоров, А. Н. Егоров</i>	12
Учет направления поляризации лазерного излучения при моделировании эффектов локальной ионизации в современных интегральных схемах <i>П. К. Скоробогатов, А. В. Согоян, Г. Г. Давыдов, А. Н. Егоров, Д. В. Савченков</i>	28
Оценка чувствительности интегральных схем к одиночным радиационным эффектам для точечной области собирания заряда <i>А. И. Чумаков</i>	34
Оценка параметров чувствительности КМОП БИС по одиночным тиристорным эффектам при лазерном воздействии со стороны подложки <i>А. А. Печенкин, Д. В. Савченков, О. Б. Маврицкий, А. И. Чумаков, Д. В. Бобровский</i>	41

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Анализ влияния температуры на импульсную электрическую прочность КМОП-микросхем <i>К. А. Епифанцев, П. К. Скоробогатов, О. А. Герасимчук</i>	49
Влияние электрического режима на показатели стойкости импульсных стабилизаторов к одиночным сбоям от ТЗЧ <i>Л. Н. Кессаринский, А. Я. Борисов, Д. В. Бойченко, А. О. Ахметов</i>	54

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Функционально-логическое моделирование деградации цифровых БИС при воздействии радиации <i>В. М. Барбашов</i>	59
Модель формирования токов утечки диэлектриков МОП-структур при воздействии ТЗЧ <i>А. В. Согоян, В. А. Полунин</i>	65

Авторский указатель тома 43, 2014 г.	71
Вниманию авторов	75